

# 水平爐管儀器簡介

機台編號	儀器名稱 / Class 100	開放等級	放置位置
CF-T03	水平爐管 Horizontal Furnace	B2	奈米 Class 100

一、水平爐管規格及型號：

1. SVCS Furnace system (含氧化、擴散及低壓化學氣相沈積系統)，for 6" wafer or 4" wafer(圓形)。
2. 單 Run 最多片數 22 片(需扣除控片及前後擋片)。

二、標準製程：

製程項目		溫度(°C)	規格
Tube01	Poly-Si/ $\alpha$ -Si(LPCVD)	620/560	200~10,000Å
Tube02	Nitride(LPCVD)	780	30~10,000Å
Tube03	TEOS-Oxide(LPCVD)	700	30~10,000Å
Tube04	Dope-AMM(LPCVD)	560	200~10,000Å
Tube05	Wet-Oxidation	980/1,100	300~10,000Å
	Dry-Oxidation	800/900	30~ 800Å
Tube06	Drive-In/N <sup>+</sup> Anneal	400~1,100	30 分鐘~48 小時
Tube07	P <sup>+</sup> Anneal	600~950	30 分鐘~48 小時
Tube08	H <sub>2</sub> Sinter	300~700	10 分鐘~2 小時(5%H <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> )
			10 分鐘~48 小時(N <sub>2</sub> )

三、特殊注意事項：

1. 委託之晶片依序填妥晶片之型式、材料、雜質種類濃度、方向、**厚度**、**直徑**、**形狀**及**數量**。
2. **除新開封晶圓外，請務必註明該晶圓先前做過 NDL 何種製程？(如：是否有含光阻....)。**
3. **拒收含缺角、光阻、金屬、不明物、III-V 族的晶圓、經非 NDL 前段設備處理的晶圓。**
4. **Nitride 應力高，若造成晶圓龜裂、刮痕、針狀物等，一概不予負責(自行考量此風險)。**
5. **若違反上述規定造成機台污染或損害，除停止其使用權並追究相關賠償責任。**